

Перечень применяемых методик измерений

- сканирующей электронной микроскопии:
 - изображение поверхности;
 - определение элементного состава материала;
 - микроскоп поддерживает режим работы в условиях переменного давления для исследования непроводящих образцов без подготовки.
 - инфракрасной и рамановской спектроскопии:
 - измерения методами комбинационного рассеяния света спектров электронных и фононных возбуждений различных систем;
 - измерения спектров фотolumинесценции, отражения и пропускания;
 - измерения время-разрешенных спектров фотolumинесценции различных веществ.
 - электронно-ионной микроскопии и электронно-зондового анализа:
 - получение изображения поверхности во вторичных (SE), обратно рассеянных (BSE) прошедших (STEM) электронах, во вторичных ионах;
 - элементный анализ состава по глубине образца;
 - получение карт распределения элементов по поверхности образца;
 - изготовление образцов для просвечивающей электронной микроскопии;
 - создание микроструктур на поверхности образцов.
 - рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии:
 - электронная Оже-спектроскопия (AES) и растровый микрозонд Оже (SAM);
 - рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФС, XPS или ЭСХА, ESCA);
 - УФ спектроскопия;
 - дифракция медленных электронов.
- Измерения могут проводиться в температурном диапазоне от -150°C до +600°C. Минимизация зарядки поверхности осуществляется с помощью нейтрализатора. Существует возможность очистки поверхности образцов ионами аргона.
- зондовой микроскопии:
 - исследование морфологии поверхности и электронных спектров полупроводников, металлов и топологических изоляторов;
 - исследование процессов роста ультратонких слоев и нанокластеров на поверхности полупроводников и топологических изоляторов.